

calculatoratoz.comunitsconverters.com

CMOS-Verzögerungseigenschaften Formeln

[Rechner!](#)[Beispiele!](#)[Konvertierungen!](#)

Lesezeichen calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Größte Abdeckung von Rechnern und wächst - **30.000+ Rechner!**

Rechnen Sie mit einer anderen Einheit für jede Variable - **Eingebaute Einheitenumrechnung!**

Größte Sammlung von Maßen und Einheiten - **250+ Messungen!**



Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu TEILEN!

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)



Liste von 13 CMOS-Verzögerungseigenschaften Formeln

CMOS-Verzögerungseigenschaften ↗

1) Abfallzeit ↗

$$fx \quad t_f = 2 \cdot t_e - t_r$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex \quad 9.2\text{ns} = 2 \cdot 6\text{ns} - 2.8\text{ns}$$

2) Anstieg verzögern ↗

$$fx \quad T_d = t_{ir} + (R_{rise} \cdot C_d) + (t_{sr} \cdot t_{prev})$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex \quad 98.484\text{ns} = 2.1\text{ns} + (7.68\text{m}\Omega \cdot 12.55\mu\text{F}) + (100\text{ns} \cdot 5.6\text{ns})$$

3) Aufstiegszeit ↗

$$fx \quad t_r = 2 \cdot t_e - t_f$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex \quad 2.8\text{ns} = 2 \cdot 6\text{ns} - 9.2\text{ns}$$

4) Ausbreitungsverzögerung ↗

$$fx \quad t_{pd} = d \cdot t_c$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex \quad 70.99878\text{ns} = 221.18 \cdot 0.321\text{ns}$$



5) Ausbreitungsverzögerung im Schaltkreis ↗

fx $t_{ckt} = \frac{t_{pHL} + t_{pLH}}{2}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $8.16\text{ns} = \frac{7\text{ns} + 9.32\text{ns}}{2}$

6) Edge-Rate ↗

fx $t_e = \frac{t_r + t_f}{2}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $6\text{ns} = \frac{2.8\text{ns} + 9.2\text{ns}}{2}$

7) Kleine Abweichungsverzögerung ↗

fx $\Delta T_{out} = K_{vcdl} \cdot \Delta V_{ctrl}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $8 = 4 \cdot 2V$

8) Laufzeitverzögerung ohne parasitäre Kapazität ↗

fx $t_c = \frac{t_{ckt}}{d}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $0.036893\text{ns} = \frac{8.16\text{ns}}{221.18}$



9) Normalisierte Verzögerung ↗

fx $d = \frac{t_{pd}}{t_c}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $221.1838 = \frac{71\text{ns}}{0.321\text{ns}}$

10) Spannungsgesteuerte Verzögerungsleitung ↗

fx $\Delta V_{ctrl} = \frac{\Delta T_{out}}{K_{vcdl}}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $2V = \frac{8}{4}$

11) VCDL-Verstärkung ↗

fx $K_{vcdl} = \frac{\Delta T_{out}}{\Delta V_{ctrl}}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $4 = \frac{8}{2V}$

12) Verzögerung des UND-ODER-Gatters in der grauen Zelle ↗

fx $t_{AO} = \frac{T_{delay} - t_{pd} - t_{XOR}}{N_{gates} - 1}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $21.88889\text{ns} = \frac{300\text{ns} - 71\text{ns} - 32\text{ns}}{10 - 1}$



13) Verzögerung von 1-Bit-Propagate-Gates ↗

fx $t_{pd} = T_{delay} - ((N_{gates} - 1) \cdot t_{AO} + t_{XOR})$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $70.9\text{ns} = 300\text{ns} - ((10 - 1) \cdot 21.9\text{ns} + 32\text{ns})$



Verwendete Variablen

- C_d Verzögerungskapazität (*Mikrofarad*)
- d Normalisierte Verzögerung
- K_{vcdl} VCDL-Verstärkung
- N_{gates} Gates auf kritischem Weg
- R_{rise} Erhebe den Widerstand (*Milliohm*)
- t_{AO} Verzögerung des UND-ODER-Gatters (*Nanosekunde*)
- t_c Ausbreitungsverzögerungskapazität (*Nanosekunde*)
- t_{ckt} Verzögerung der Schaltungsausbreitung (*Nanosekunde*)
- T_d Verzögerungsanstieg (*Nanosekunde*)
- T_{delay} Kritische Pfadverzögerung (*Nanosekunde*)
- t_e Kantenrate (*Nanosekunde*)
- t_f Abfallzeit (*Nanosekunde*)
- t_{ir} Eigene Anstiegsverzögerung (*Nanosekunde*)
- t_{pd} Gesamtausbreitungsverzögerung (*Nanosekunde*)
- t_{pHL} Ausbreitungsverzögerung von hoch nach niedrig (*Nanosekunde*)
- t_{pLH} Ausbreitungsverzögerung niedrig bis hoch (*Nanosekunde*)
- t_{prev} Zurück verzögern (*Nanosekunde*)
- t_r Aufstiegszeit (*Nanosekunde*)
- t_{sr} Hanganstieg (*Nanosekunde*)
- t_{XOR} XOR-Gate-Verzögerung (*Nanosekunde*)



- ΔT_{out} Kleine Abweichungsverzögerung
- ΔV_{ctrl} Spannungsgesteuerte Verzögerungsleitung (Volt)



Konstanten, Funktionen, verwendete Messungen

- **Messung:** Zeit in Nanosekunde (ns)
Zeit Einheitenumrechnung ↗
- **Messung:** Kapazität in Mikrofarad (μF)
Kapazität Einheitenumrechnung ↗
- **Messung:** Elektrischer Widerstand in Milliohm ($\text{m}\Omega$)
Elektrischer Widerstand Einheitenumrechnung ↗
- **Messung:** Elektrisches Potenzial in Volt (V)
Elektrisches Potenzial Einheitenumrechnung ↗



Überprüfen Sie andere Formellisten

- Array-Datenpfad-Subsystem
[Formeln ↗](#)
- Eigenschaften der CMOS-Schaltung [Formeln ↗](#)
- CMOS-Verzögerungseigenschaften
[Formeln ↗](#)
- CMOS-Designmerkmale
[Formeln ↗](#)
- CMOS-Leistungsmetriken
[Formeln ↗](#)
- Logische Schaltkreise
[Formeln ↗](#)
- Subsystem für besondere Zwecke
[Formeln ↗](#)

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu **TEILEN!**

PDF Verfügbar in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

10/31/2023 | 4:51:40 AM UTC

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)

